









	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB180P04P4L02ATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 40V 180A TO263-7</p>
	<p>Datenblätter:  IPB180P04P4L02ATMA1.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPB180P04P4L02ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET P-CH 40V 180A TO263-7
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 410µA
Vgs (Max)	±16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-7-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.4 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	150W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-7, D²Pak (6 Leads + Tab), TO-263CB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	18700pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	286nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	180A (Tc)

IPB180P04P4L02ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB180P04P4L02ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB180P04P4L02ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB180P04P4L02ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB180N10S4 Original TO263-7</p>	 <p>IPB180P04P403ATMA1 Infineon Technologies MOSFET P-CH TO263-7</p>	 <p>IPB200N15N3 Infineon IPB200N15N3 Infineon</p>	 <p>IPB180N10S403ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-7</p>
 <p>IPB180P04P4L-02 INFINEO IPB180P04P4L-02 INFINEO</p>	 <p>IPB200N15N3G INFINEO IPB200N15N3G INFINEO</p>	 <p>IPB200N15N3 G Infineon Technologies IPB200N15N3 G Infineon Technologies</p>	 <p>IPB200N15N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 150V 50A TO263-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB180P04P4L02ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB180P04P4L02ATMA1 Datenblatt	IPB180P04P4L02ATMA1-Datenblätter	IPB180P04P4L02ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB180P04P4L02ATMA1
IPB180P04P4L02ATMA1 Electronic	IPB180P04P4L02ATMA1-Komponenten	IPB180P04P4L02ATMA1-Verteiler	IPB180P04P4L02ATMA1-Bild	IPB180P04P4L02ATMA1-Teil
IPB180P04P4L02ATMA1 Preis	IPB180P04P4L02ATMA1 Hersteller	IPB180P04P4L02ATMA1 Bild	IPB180P04P4L02ATMA1 Aktie	IPB180P04P4L02ATMA1 Inventar
IPB180P04P4L02ATMA1 Neu	IPB180P04P4L02ATMA1 Original	IPB180P04P4L02ATMA1 garantiert	IPB180P04P4L02ATMA1 RFQ	IPB180P04P4L02ATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited